

IGBT 大项落户嘉善，总投资 7.5 亿美元

来源：嘉善发布

7 月 16 日，注册资金 2.5 亿美元，总投资 7.5 亿美元 IGBT 功率半导体项目正式签约落户嘉善经济技术开发区。该功率半导体项目，主要从事高端绝缘栅双极型晶体管的自主研发和制造，一期达产后预计年产值将超过 20 亿元。同时，项目还将在县开发区设立 IGBT 技术研发中心，全面支持企业的创新发展。

IGBT 功率半导体项目的主要投资方为赛晶电力电子集团。经过十五年发展，华瑞赛晶目前已经成为全国乃至全球最有影响力的电力系统解决方案供应商，其自主研发的阳极饱和电抗器和柔性直流输电大功率电力电子电容器都打破了国外技术的垄断。

据悉，高端绝缘栅双极型晶体管是能源变换与传输的核心器件，电力电子装置的“CPU”，其在轨道交通、智能电网、新能源汽车等领域中有着广泛的运用。该产品由于对设计和制造工业要求高，国内起步晚，国内市场长期为国外企业所把持。项目的落地将加速这一核心元器件的国产化进程。

文章收入时间：2019-07-17